

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS) (TENTATIVE)

2SA493

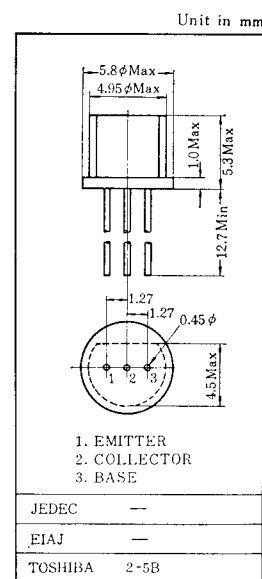
○ 低周波低雑音増幅用

○ Low Noise Audio Amplifier Applications

- 高耐圧です:  $V_{CE0} = -50V$
- 低雑音です:  $NF = 2dB$  (Max.) ( $f = 120Hz$ ,  $R_g = 10 k\Omega$ )

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-50	mA
エミッタ電流	$I_E$	50	mA
コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合温度	$T_J$	125	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~125	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -30V$ , $I_E = 0$	—	—	-100	nA
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = -5V$ , $I_C = 0$	—	—	-100	nA
直流電流増幅率 (Note)	$h_{FE}$	$V_{CE} = -6V$ , $I_C = -2mA$	120	—	400	
雑音指数	NF(1)	$V_{CE} = -6V$ , $I_E = 100\mu A$ , $f = 10Hz$ , $R_g = 10 k\Omega$	—	—	10	dB
	NF(2)	$V_{CE} = -6V$ , $I_E = 100\mu A$ , $f = 120Hz$ , $R_g = 10 k\Omega$	—	—	2	dB

Note ;  $h_{FE}$  により下表のように分類し, 現品表示してあります.

According to the value of  $h_{FE}$ , the 2SA493 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA493—Y	120	240
2SA493—GR	200	400